

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ШУМА
НА ВЫСОКИХ И СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ

ГОСТ 18604.11—88
(СТ СЭВ 3996—83)

Издание официальное

Б3 7—88/479

Цена 5 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

Метод измерения коэффициента шума на высоких и сверхвысоких частотах

Bipolar transistors. Method of measuring noise figure at high and ultra-high frequencies

ГОСТ

18604.11—88

(СТ СЭВ 3996—83)

ОКП 62 2312

Срок действия с 01.01.90
до 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на биполярные транзисторы и устанавливает метод измерения коэффициента шума $K_{шт}$ на высоких и сверхвысоких частотах в диапазоне частот $1 \cdot 10^4$ до $12,0 \text{ ГГц}$.

Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 18604.0—83.

Термины и пояснения к ним приведены в приложении 1.

I. ПРИНЦИП, УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИИ

1.1. Коэффициент шума транзистора $K_{шт}$ представляет собой параметр, показывающий во сколько раз ухудшается соотношение сигнал/шум на определенной частоте за счет собственных шумов транзистора.

1.2. Значение ($K_{шт}$) транзистора в общем случае определяется формулой

$$K_{шт} = \frac{P_{ш} + P_{шт}}{P_{ш}}, \quad (1)$$

где $P_{ш}$ — мощность шума источника сигнала, Вт;

$P_{шт}$ — мощность шума транзистора, Вт.

Для диапазона частот, в котором мощность шума ($P_{ш}$) источника сигнала определяют по формуле

$$P_{ш} = K T_n \Delta f, \quad (2)$$



где K — постоянная Больцмана, равная $1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К; $T_{\text{ш}}$ — эквивалентная эффективная шумовая температура (ЭШТ) источника сигнала, К; Δf — эквивалентная полоса частот измерителя шумовой мощности, Гц, отношение мощности шума в правой части формулы (1) можно заменить отношением эквивалентных шумовых температур. Тогда значение ($K_{\text{ш}} \text{тр}$) рассчитывают по формуле

$$K_{\text{ш}} \text{тр} = \frac{T_{\text{ш}} + T_{\text{е}} \text{тр}}{T_{\text{ш}}} = 1 + \frac{T_{\text{е}} \text{тр}}{T_{\text{ш}}}, \quad (3)$$

где $T_{\text{е}} \text{тр}$ — ЭШТ, приведенная к входу транзистора (ЭШТВ). $K_{\text{ш}} \text{тр}$ транзистора, работающего в линейном режиме зависит не только от свойств самого транзистора, но и от коэффициента отражения источника сигнала. Этую зависимость определяют по формуле

$$K_{\text{ш}} \text{тр} = K_{\text{ш} \text{min}} + S \cdot \frac{|\Gamma_{\text{ш}} - \Gamma_{\text{opt}}|^2}{1 - |\Gamma_{\text{sh}}|^2}, \quad (4)$$

где $K_{\text{ш} \text{min}}$ — минимальный коэффициент шума; S — коэффициент, характеризующий степень зависимости $K_{\text{ш}}$ транзистора от условий согласования на его входе; $\Gamma_{\text{ш}}$ — комплексный коэффициент отражения источника сигнала; Γ_{opt} — комплексный коэффициент отражения источника сигнала, при котором $K_{\text{ш}}$ минимален.

Таким образом $K_{\text{ш}} \text{тр}$ характеризует шумовые свойства транзистора при его работе с источником сигнала, имеющим определенные ЭШТ и коэффициент отражения.

1.3. Для единого измерения ($K_{\text{ш}} \text{тр}$) используют стандартный $K_{\text{ш}}$, который определяют по формуле

$$K_{\text{ш}} = 1 + \frac{T_{\text{е}} \text{тр}}{T_0}, \quad (5)$$

где T_0 — стандартная температура источника сигнала, равная 293 К (20°C).

В качестве источника сигнала с ЭШТ, равной T_0 , используют резистивную или поглощающую нагрузку, которая согласована в линии передачи и имеет температуру T_0 . Номинальную мощность шума ($P_{\text{шо}}$) такого источника сигнала определяют по формуле

$$P_{\text{шо}} = K T_0 \Delta f. \quad (6)$$

В процессе измерения $K_{\text{ш}}$ осуществляют контроль суммарной мощности шума на выходе измеряемого транзистора. Информация

о шумовых свойствах транзистора содержится только во втором слагаемом (см. формулы 1 и 3).

1.4. При измерении малошумящих транзисторов $K_{ш} < 2 \text{ дБ}$ для повышения информативности и снижения погрешности измерения рекомендуется снижать мощность шума источника сигнала за счет уменьшения T_n и проводить измерение с использованием низкотемпературного генератора шума (НГШ) вместо источника сигнала со стандартной эквивалентной температурой T_0 . При этом номинальную мощность шумов от НГШ на входе транзистора $P_{ш, \text{ход}}$ определяют по формуле

$$P_{ш, \text{ход}} = K T_{\text{ход}} \Delta f, \quad (7)$$

где $T_{\text{ход}}$ — эквивалентная шумовая температура на выходе НГШ.

1.5. При использовании НГШ измеритель шумовой мощности измеряет суммарную мощность шума ($P_{ш, \Sigma}$), пересчитанную ко входу

$$P_{ш, \Sigma} = P_{ш, \text{ход}} + P_{ш, \text{тр}} = K \Delta f (T_{\text{ход}} + T_{e, \text{тр}}). \quad (8)$$

В соответствии с формулой (8) при использовании НГШ в процессе измерения $K_{ш}$ в результате первоначальной обработки сигнала определяют рабочий коэффициент шума ($K_{ш, \text{раб}}$) или реальный коэффициент шума ($K_{ш, \text{ход}}$)

$$K_{ш, \text{раб}} = \frac{P_{ш, \text{ход}} + P_{ш, \text{тр}}}{P_{ш, \text{ход}}} = \frac{T_{\text{ход}} + T_{e, \text{тр}}}{T_0}; \quad (9)$$

$$K_{ш, \text{ход}} = \frac{P_{ш, \text{ход}} + P_{ш, \text{тр}}}{P_{ш, \text{ход}}} = \frac{T_{\text{ход}} + T_{e, \text{тр}}}{T_{\text{ход}}}. \quad (10)$$

Значение стандартного $K_{ш}$, заданного в технических условиях на транзистор конкретного типа, определяют в процессе дальнейшей обработки результатов измерений по формулам (19) и (23).

1.6. Для определения $K_{ш}$ необходимо проводить измерения при подаче на вход измеряемого транзистора нескольких уровней шумовой мощности, например $K T_n \Delta f$ и $K(T_n + \Delta T_{\text{ГШ}}) \Delta f$. В соответствии с этим источник сигнала ГШ или НГШ на входе измеряемого транзистора может иметь ЭШТ, равную T_n , когда ГШ выключен, или ЭШТ, равную $T_n + \Delta T_{\text{ГШ}}$, когда ГШ включен.

1.7. Режим питания по постоянному току, условия согласования на входе и выходе измеряемого транзистора и, при необходимости, конкретную схему измерения указывают в технических условиях на транзистор конкретного типа.

Рекомендуется задавать минимальный коэффициент шума ($K_{ш, \text{мин}}$), при этом полное сопротивление источника сигнала на входе измеряемого транзистора должно соответствовать настройке на минимальное значение $K_{ш}$.